

КТ645А,Б

**PNP КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЙ
ТРАНЗИСТОР**

аАО.336.333 ТУ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В АППАРАТУРЕ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

- * Зарубежный аналог – BC547, BC238
- * Изготавливается в корпусе **КТ-26 (ТО-92)**.



1 – Коллектор 2 – База 3 – Эмиттер

ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры		Обозначение	Ед. измер.	Значение
Напряжение коллектор-база	КТ645А	U _{кб} max	В	60
	КТ645Б			40
Напряжение коллектор-эмиттер	КТ645А	U _{кэ} max	В	50
	КТ645Б			40
Напряжение эмиттер-база	КТ645А	U _{эб} max	В	4
	КТ645Б			5
Постоянный ток коллектора		I _к max	мА	300
Импульсный ток коллектора (t _и ≤ 10 мс, Q ≥ 5)		I _{ки} max	мА	600
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора		P _к max	мВт	500
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора		P _и max	мВт	1000
Температура перехода		T _п	°С	150

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (T_{окр.ср.}=25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение коллектор - эмиттер	U _{кэо} гр.*	В	I _к = 10мА, I _б =0	30	
Обратный ток коллектора	I _{кбо}	мкА	U _{кб} =40 - 60В, I _э =0		10
Статический коэффициент передачи тока	h _{21E}		U _{кб} =2В, I _э =150мА	20	200
			U _{кб} =10В, I _э =2мА	80	
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер	U _{кэ(нас)}	В	I _к =150мА, I _б =15мА		0,5
			I _к =10мА, I _б =1мА		0,05
Напряжение насыщения база - эмиттер	U _{бэ(нас)*}	В	I _к =150мА, I _б =15мА		1,2
Время рассасывания	KT645А	t _{рас}	нс	I _{б1} =I _{б2} =15мА, I _к =150мА	50
Емкость коллекторного перехода	С _к	пФ	U _{кб} =10В, f=10МГц		5
Граничная частота коэффициента передачи тока	f _{гр} *	МГц	U _{кэ} =10В, I _к =50мА	250	
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте	τ _к *	пс	U _{кб} =5В, I _э =5мА, f=5МГц		120

* Справочные параметры

220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"

Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by <http://www.transistor.by>